PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-226765

(43) Date of publication of application: 12.08.2003

(51)Int.CI.

C08J 5/18 C08L 79/00 C08L 79/08 H01B 1/20 H01B 13/00

(21)Application number: 2002-363407

27.03.1995

(71)Applicant: NITTO DENKO CORP

(72)Inventor: UETANI YOSHIHIRO

NAKAMURA MASAO

ABE MASAO

(54) SEMICONDUCTIVE RESIN SHEET AND ITS PRODUCTION METHOD

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductive resin sheet having stabilized electroconductivity against the change of the environment, and its production method. SOLUTION: The semiconductive resin sheet is composed of a polymer blend of a polyimide and a polyaniline in a dedoped state, and has an elastic modulus of ≥200 kgf/mm2 and a volume resistivity of 107–1014 Ωcm. Such a semiconductive resin sheet can be obtained by casting a film-forming solution containing a polymic acid and a polyaniline in a dedoped state on to a substrate to form a layer of the above solution on the substrate, heating the layer of the solution to form a resin sheet on the substrate, subsequently peeling the resin sheet from the substrate, and then heating the sheet to imidate the polyamic acid.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.12.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-226765 (P2003-226765A)

(43)公開日 平成15年8月12日(2003.8.12)

			(30) 23 50	H TM104	6 A 12 D (2003. 6. 12)
(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
CO8J 5/18	CFG	C 0 8 J	5/18	CFG	
COSL 79/00		C08L 7	9/00		A 4J002
79/08		7:	9/08		Z 5G301
H 0 1 B 1/20		H 0 1 B	1/20		В
13/00		1:	3/00		Z
		審査請求	有 請	求項の数4	OL (全 8 頁)
(21)出願番号 特願2002-363407(P2002-363407)		(71)出願人	00000396	34	SPECIAL CONTRACTOR
(62)分割の表示	特願平7-67513の分割			株式会社	
(22)出顧日	平成7年3月27日(1995.3.27)	大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号			
		(72)発明者	植谷 慶	裕	
			大阪府茨	木市下穂積1	丁目1番2号 日東
			電工株式	会社内	
		(72)発明者	中村 正	雄	
			大阪府茨	木市下穂積1	丁目1番2号 日東
			電工株式	会社内	
	·	(74)代理人	代理人 100079120		
			弁理士	牧野 逸郎	
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導電性樹脂シートとその製造方法

(57)【要約】

【課題】環境の変化に対しても、安定した導電性を有する半導電性樹脂シートとその製造方法を提供する。

【解決手段】本発明による半導電性樹脂シートは、ポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなり、弾性率が $200 \log f/mm^2$ 以上であり、体積抵抗率が $10^7 \sim 10^{14} \Omega \cdot cm$ の範囲にある。このような半導電性樹脂シートは、ポリアミド酸と脱ドープ状態のポリアニリンとを含む製膜溶液を基材上にキャステイングし、基材上に上記溶液の層を形成し、加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、その樹脂シートを基材から剥離した後、加熱して、ポリアミド酸をイミド化させることによって得ることができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】ポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなり、弾性率が $2 \circ O \circ R$ が $1 \circ O \circ O \circ R$ 知上であり、体積抵抗率が $1 \circ O \circ O \circ O \circ O \circ O \circ O \circ O$ 田にある半導電性樹脂シート。

【請求項2】ポリアニリンが式(川)

【化1】

で表されるイミノーpーフェニレン構造の繰返し単位からなるものである請求項1に記載の半導電性樹脂シート。

【請求項3】ポリアミド酸と脱ドープ状態のポリアニリンとを含む製膜溶液を基材上にキャステイングし、基材上に上記製膜溶液の層を形成し、60~200℃の温度に加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、その樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シートを250~400℃の温度に加熱して、ポリアミド酸をイミド化させることを特徴とするポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなり、弾性率が200kgf/mm²以上であり、体積抵抗率が107~1014Ω・cmの範囲にある半導電性樹脂シートの製造方法。

【請求項4】ポリアニリンが式(川)

【化2】

で表されるイミノーpーフェニレン構造の繰返し単位からなるものである請求項3に記載の半導電性樹脂シートの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリイミドと共に、脱ドープ状態又はドープ状態のポリアニリンを含むポリマーブレンドからなり、半導電性を有し、強靱で機械的特性にすぐれる半導電性樹脂シートと、そのような半導電性樹脂シートは、例えば、電池の電極材料、電磁シールド材、静電吸着用フィルム、帯電防止材、画像形成装置部品、電子デバイス等において好適に用いることができる。

[0002]

【従来の技術】従来、ポリイミドにカーボン、カーボン 繊維、グラファイト、金属粒子、金属酸化物粒子等の導 電性充填剤を配合することによって、ポリイミドを導電 性にすることができることは、既に知られている。しか しながら、これらの導電性充填剤をポリイミドに配合して、導電性を有するシートとしたとき、得られるシートは、機械特性に劣り、特に、シートに「しなやかさ」がなく、シートの加工時や使用時に、それに加わる張力に耐えることができず、切断したり、又は破れたりする問題がある。また、このような方法によれば、得られるポリイミドのシートにおいて、所要の表面抵抗率を再現性よく、且つ、均一に付与することが困難である。

【0003】他方、導電性ポリアニリンと他の樹脂とからなる半導電性ポリマーブレンドは、例えば、特開平4-63865号公報に記載されているように、既に知られている。この半導電性ポリマーブレンドは、脱ドープ状態、即ち、ドーパントによってドーピングされていないポリアニリンと他の樹脂との混合物を調製し、その後にこれにドーパントにてドーピング処理を施してなるのであるので、水分や熱によってドーパントが脱ドープしやすく、従って、その電気抵抗値が環境によって化しやすいという問題を有している。更に、上記方法によって導電性ポリマーブレンドを得るには、製膜、ドーピング、洗浄及び乾燥という多くの工程を要するという問題もある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の半導電性樹脂シートにおける上述したような問題を解決するためになされたものであって、環境の変化に対しても、安定した半導電性を有する半導電性樹脂シートとその製造方法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明による半導電性樹脂シートは、ポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなり、弾性率が200 kgf/mm 以上であり、体積抵抗率が $107 \sim 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$ の範囲にあることを特徴とする。

【0006】このような半導電性樹脂シートは、本発明に従って、ポリアミド酸と脱ドープ状態のポリアニリンとを含む製膜溶液を基材上にキャステイングし、基材上に上記製膜溶液の層を形成し、60~200℃の温度に加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、その樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シートを250~400℃の温度に加熱して、ポリアミド酸をイミド化させることによって得ることができる。

【〇〇〇7】更に、本発明によれば、ポリイミドと共に、ドープ状態のポリアニリン、即ち、ドーパントによってドープされているポリアニリンを含むポリマーブレンドからなり、より高い導電性を有する半導電性樹脂シートの製造方法も提供される。即ち、このような半導電性樹脂シートは、本発明に従って、ポリアミド酸とポリアニリンとこのポリアニリンをドーピングして導電性とすることができるドーパントを含む製膜溶液を基材上にキャステイングし、基材上に上記製膜溶液の層を形成

し、60~200℃の温度に加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、その樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シートを250~400℃の温度に加熱して、ポリアミド酸をイミド化させることによって得ることができる。

【0008】本発明によれば、上記ポリマーブレンドからなる半導電性樹脂シートにおいて、脱ドープ状態又はドープ状態のポリアニリンは、1~90重量%の範囲であることが好ましい。

【0009】本発明において、半導電性樹脂シートとは、体積抵抗率が $10^7 \sim 10^{15} \Omega \cdot cm$ の範囲にある樹脂シートをいう。

【0010】ポリアミド酸は、既に知られているように、テトラカルボン酸二無水物又はその誘導体とジアミンとのほぼ等モル混合物を有機極性溶媒に溶解させ、溶液状態で反応させることによって、溶液として得ることができる。従って、ポリアミド酸は、ポリイミドの前駆体として調製されるものであって、このようなポリアミド酸を加熱することによって、不溶不融のポリイミドを形成する。

【0011】本発明によれば、このようなポリアミド酸として、特に、芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンとの反応によって得られるポリアミド酸が好ましく用いられる。

【0012】本発明によれば、上述したようにして、ポリアミド酸の溶液を調製し、別に、脱ドープ状態のポリアニリンの溶液か、又は脱ドープ状態のポリアニリンをドーピングして導電性とすることができるドーパントを含む溶液を調製し、これらの溶液を混合して、製膜溶液とし、これを適宜の基材、例えば、ガラス、金属、樹脂等からなるシートの表面や、又はガラス、金属、樹脂等からなるをであるでは、ガラス、金属、樹脂等からなるがであるとは内表面では、ボリイミド化することによって、ポリイミドとポリアニリとのポリマーブレンドからなる半導電性樹脂シートを得ることができる。上記管状の基材を用いるときは、チューブ状の製品を得ることができるが、本発明においては、このようなチューブ状の製品もシートに含めることとする。

【0013】ポリアミド酸の調製において、上記芳香族テトラカルボン酸二無水物としては、例えば、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーナフタレンテトラカルボン酸二無

水物、1.4.5.8ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2.2'ービス(3.4ージカルボキシフェニル)プロパン二無水物、ビス(3.4ージカルボキシフェニル)スルホン二無水物等を挙げることができる。これらは単独で用いられてもよく、また、複数が併用されてもよい。

【0014】上記芳香族ジアミンとしては、例えば、4.4'ージアミノジフェニルエーテル、4.4'ージアミノジフェニルメタン、pーフェニレンジアミン、ベンチジン、3.3'ージメトキシベンチジン、4.4'ージアミノジフェニルスルホン、4.4'ージアミノジフェニルスルホン、4.4'ージアミノジフェニルスルホン(4.4'ージアミノジフェニルプロパン、2.2ービス「4ー(4ーアミノフェノキシ)フェニル〕プロパン等を挙げることができる。これらも、単独で用いられてもよく、また、複数が併用されてもよい。

【0015】また、上記有機極性溶媒としては、例えば、Nーメチルー2ーピリリドン、N.Nージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチレンホスホルトリアミド等を挙げることができる。これらの有機極性溶媒には、必要に応じて、クレゾール、フェノール、キシレノール等のフェノール類、ヘキサン、ベンゼン、トルエン等の炭化水素類等を混合することができる。これらの溶剤も、単独で、又は2種以上の混合物として用いられる。

【0016】上記芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンを上記溶媒中で溶液状態で反応させて、ポリアミド酸の溶液を得る際の有機溶媒中での上記無水物とジアミンとからなる原料量の濃度は、通常、5~30重量%、好ましくは10~25重量%の範囲である。用いる無水物とジアミンとにもよるが、通常、80℃以下、好ましくは、5~50℃の範囲の温度で約2~10時間反応させることによって、ポリアミド酸を溶液として得ることができる。

【0017】芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンとを溶液状態で反応させるとき、反応の進行と共に、溶液の粘度が上昇するが、本発明においては、温度30℃にてNーメチルー2ーピドリドン溶液として測定した固有粘度が0.5以上のポリアミド酸溶液を調製し、これを用いることが好ましい。このように、固有粘度が0.5以上のポリアミド酸溶液を用いることによって、機械強度の信頼性がすぐれるシートを得ることができる。

【 O O 1 8 】次に、本発明において用いるポリアニリンは、一般式 (I)

[0019]

【化3】

(1)

【0020】(式中、m及びnはそれぞれ繰り返し単位中のキノンジイミン構造単位及びフェニレンジアミン構造単位のモル分率を示し、0~m~1、0~n~1、m+n=1である。)で表されるキノンジイミン構造単位を主たる繰り返し単位として有し、脱トープ状態において溶剤に可溶性のポリアニリンである。以下、このようなポリアミドをキノンジイミン・フェニレンジアミン型ポリアニリンということがある。このようなポリアニリンの性質と製造については、特開平3-28229号公報に詳細に記載されている。

【0021】特に、本発明において用いるポリアニリン は、特開平3-28229号公報に記載されているよう に、脱ドープ状態において457.9 nmの波長の光で励 起して得られるレーザー・ラマンスペクトルにおけるパ ラ置換ペンゼンの骨格振動のうち、1600cm⁻¹よりも 高波数にあらわれる骨格延伸振動のラマン線の強度Ia と1600cm-1よりも低波数にあらわれる骨格延伸振動 のラマン線強度 【bの比【a/【bが1. 〇以上であるこ とが好ましい。更に、本発明において用いるポリアニリ ンは、Nーメチルピロリドン中、30℃で測定した極限 粘度 $[\eta]$ が0.40dl/g以上であることが好ましい。 かかるレーザー・ラマンスペクトル特性を有するポリア ニリンは、特開平3-28229号公報に詳細に記載さ れているように、従来より知られているポリアニリンに 比べて、高分子量であり、溶剤可溶性である点で区別さ れ、更に、構造的にも区別され得る。

【0022】本発明において用いる上記キノンジィミン ・フェニレンジアミン型ポリアニリンであって、脱ドー プ状態において有機溶剤に可溶性であり、所定の極限粘 度と前述したレーザー・ラマンスペクトル特性を有する ポリアニリンは、特開平3-28229号公報に詳細に 記載されているように、酸解離定数 pKa値が3. O以下で あるプロトン酸の存在下に溶剤中にてアニリンに温度を 5℃以下、好ましくは0℃以下の温度を保持しつつ、標 準水素電極を基準とする還元半電池反応における起電力 として定められる標準電極電位が0.6 V以上である酸化 剤の水溶液をアニリン1モル当たりに、酸化剤の1モル を、酸化剤 1 分子を還元するのに必要な電子数で割った 量として定義される当量で、2当量以上、好ましくは2 ~2. 5 当量徐々に加えて、上記プロトン酸にてドープさ れたアニリンの酸化重合体(以下、ドープされたポリア ニリンという。)を生成させ、次いで、このドープされ たポリアニリンを塩基性物質によって脱ドープすること によって得ることができる。

【0023】このように、プロトン酸の存在下にアニリンを酸化重合して、ドープ状態のポリアニリンを得、次いで、このポリアニリンを脱ドープして得られるポリアニリンは、高分子量を有し、しかも、種々の有機溶剤に溶解する。かかる有機溶剤としては、Nーメチルー2ーゼリドン、N,Nージメチルアセトアミド、N,Nージメチルスルホキシド、1,3ージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、スルホラン等を挙げることができる。このような脱ドープ状態のポリアニリンの平均分子量や溶剤にもよるが、重合体の0.5~100%が溶解し、1~30量%の溶液を得ることができる。本発明において用いるこのような脱ドープ状態のポリアニリンは、それ自体が半導電性を有する。

【0024】本発明によれば、前述したように、ポリアミド酸と脱ドープ状態のポリアニリンと(このポリアニリンをドーピングして導電性とすることができるドーパントと)を含む製膜溶液を調製し、この製膜溶液を適関の基材、例えば、ガラス板上にキャステイングし、製膜溶液の層を基材上に形成し、60~200℃の温度にかいて、その樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シートを表材から剥離し、ポリアミド酸をイミド化させることによって、ポリイミドと(脱)ドープ状態の導電性ポリアニリンとのポリマーブレンドからなる半導電性樹脂シートを得ることができる。

【0025】本発明において、ポリアニリンをドーピングして、導電性とするためのドーパントとしては、プロトン酸を好ましく用いることができる。ドーパントとして好ましいプロトン酸は、酸溶解定数 pKa値が4.8以下であるプロトン酸である。そのようなプロトン酸として、例えば、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、ホウフッ化水素酸、リンフッ化水素酸、過塩素酸等の無機酸のほか、酸溶解定数 pKa値が4.8以下である有機酸を挙げることができる。

【0026】本発明において用いる有機酸は、例えば、有機カルボン酸又はフェノール類であって、好ましくは、酸解離定数 pKa値が4.8以下であるものである。このような有機酸としては、脂肪族、芳香族、芳香脂肪族、脂環式等の一又は多塩基酸を含む。このような有機酸は、水酸基、ハロゲン、ニトロ基、シアノ基、アミノ基等を有していてもよい。従って、かかる有機酸の具体例として、例えば、酢酸、nー酪酸、ペンタデカフルオ

ロオクタン酸、ペンタフルオロ酢酸、トリフルオロ酢 酸、トリクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、モノフルオロ酢 酸、モノブロモ酢酸、モノクロロ酢酸、シアノ酢酸、ア セチル酢酸、ニトロ酢酸、トリフエニル酢酸、ギ酸、シ ュウ酸、安息香酸、mーブロモ安息香酸、pークロロ安 息香酸、mークロロ安息香酸、pークロロ安息香酸、o **ーニトロ安息香酸、2.4ージニトロ安息香酸、3.5ージ** ニトロ安息香酸、ピクリン酸、oークロロ安息香酸、p ーニトロ安息香酸、mーニトロ安息香酸、トリメチル安 息香酸、pーシアノ安息香酸、mーシアノ安息香酸、チ モールブルー、サリチル酸、5-アミノサリチル酸、o ーメトキシ安息香酸、1,6-ジニトロー4-クロロフェ ノール、2,6ージニトロフェノール、2,4ージニトロフ ェノール、pーオキシ安息香酸、ブロモフェノールブル 一、マンデル酸、フタル酸、イソフタル酸、マレイン 酸、フマル酸、マロン酸、酒石酸、クエン酸、乳酸、コ ハク酸、 α -アラニン、 β -アラニン、グリシン、グリ コール酸、チオグリコール酸、エチレンジアミンーN, N'-二酢酸、エチレンジアミン-N, N, N', N'-四酢 酸等を挙げることができる。

【〇〇27】また、有機酸は、スルホン酸又は硫酸基を 有するものであつてもよい。このような有機酸として は、例えば、アミノナフトールスルホン酸、メタニル 酸、スルファニル酸、アリルスルホン酸、ラウリル硫 酸、キシレンスルホン酸、クロロベンゼンスルホン酸、 メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、1-プロパンス ルホン酸、1-ブタンスルホン酸、1-ヘキサンスルホ ン酸、1-ヘプタンスルホン酸、1-オクタンスルホン 酸、1-ノナンスルホン酸、1-デカンスルホン酸、1 - ドデカンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、スチレン スルホン酸、p-トルエンスルホン酸、ナフタレンスル ホン酸、エチルベンゼンスルホン酸、プロピルベンゼン スルホン酸、ブチルベンゼンスルホン酸、ペンチルベン ゼンスルホン酸、ヘキシルベンゼンスルホン酸、ヘプチ ルベンゼンスルホン酸、オクチルベンゼンスルホン酸、 ノニルベンゼンスルホン酸、デシルベンゼンスルホン 酸、ウンデシルベンゼンスルホン酸、ドデシルベンゼン スルホン酸、ペンタデシルベンゼンスルホン酸、オクタ デシルベンゼンスルホン酸、ジエチルベンゼンスルホン 酸、ジプロピルベンゼンスルホン酸、ジブチルベンゼン スルホン酸、メチルナフタレンスルホン酸、エチルナフ タレンスルホン酸、プロピルナフタレンスルホン酸、ブ チルナフタレンスルホン酸、ペンチルナフタレンスルホ ン酸、ヘキシルナフタレンスルホン酸、ヘプチルナフタ レンスルホン酸、オクチルナフタレンスルホン酸、ノニ ルナフタレンスルホン酸、デシルナフタレンスルホン 酸、ウンデシルナフタレンスルホン酸、ドデシルナフタ レンスルホン酸、ペンタデシルナフタレンスルホン酸、 オクタデシルナフタレンスルホン酸、ジメチルナフタレ ンスルホン酸、ジェチルナフタレンスルホン酸、ジプロ ピルナフタレンスルホン酸、ジブチルナフタレンスルホン酸、ジペンチルナフタレンスルホン酸、ジヘキシルナフタレンスルホン酸、ジオクチルナフタレンスルホン酸、ジノニルナフタレンスルホン酸、トリメチルナフタレンスルホン酸、トリプロピルナフタレンスルホン酸、トリブチルナフタレンスルホン酸、カンフアースルホン酸、アクリルアミド・tーブチルスルホン酸等を挙げることができる。

【0028】また、本発明においては、分子内に2つ以 上のスルホン酸基を有する多官能有機スルホン酸も用い ることができる。このような多官能有機スルホン酸とし ては、例えば、エタンジスルホン酸、プロパンジスルホ ン酸、ブタンジスルホン酸、ペンタンジスルホン酸、ヘ キサンジスルホン酸、ヘプタンジスルホン酸、オクタン ジスルホン酸、ノナンジスルホン酸、デカンジスルホン 酸、ベンゼンジスルホン酸、ナフタレンジスルホン酸、 トルエンジスルホン酸、エチルベンゼンジスルホン酸、 プロピルベンゼンジスルホン酸、ブチルベンゼンジスル ホン酸、ジメチルベンゼンジスルホン酸、ジエチルベン ゼンジスルホン酸、ジプロピルベンゼンジスルホン酸、 ジブチルベンゼンジスルホン酸、メチルナフタレンジス ルホン酸、エチルナフタレンジスルホン酸、プロピルナ フタレンジスルホン酸、ブチルナフタレンジスルホン 酸、ペンチルナフタレンジスルホン酸、ヘキシルナフタ レンジスルホン酸、ヘプチルナフタレンジスルホン酸、 オクチルナフタレンジスルホン酸、ノニルナフタレンジ スルホン酸、ジメチルナフタレンジスルホン酸、ジエチ ルナフタレンジスルホン酸、ジプロピルナフタレンジス ルホン酸、ジブチルナフタレンジスルホン酸、ナフタレ ントリスルホン酸、ナフタレンテトラスルホン酸、アン トラセンジスルホン酸、アントラキノンジスルホン酸、 フェナントレンジスルホン酸、フルオレノンジスルホン 酸、カルバゾールジスルホン酸、ジフエニルメタンジス ルホン酸、ビフエニルジスルホン酸、ターフェニルジス ルホン酸、ターフェニルトリスルホン酸、ナフタレンス ルホン酸-ホルマリン縮合物、フェナントレンスルホン 酸ーホルマリン縮合物、アントラセンスルホン酸ーホル マリン縮合物、フルオレンスルホン酸ーホルマリン縮合 物、カルバゾールスルホン酸ーホルマリン縮合物等を挙 げることができる。芳香環におけるスルホン酸基の位置 は任意である。

【〇〇29】更に、本発明において、有機酸はポリマー酸であってもよい。このようなポリマー酸としては、例えば、ポリビニルスルホン酸、ポリビニル硫酸、ポリスチレンーブタジエン共重合体、ポリアリルスルホン酸、ポリー2ーアクリルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸、ポリハロゲン化アクリル酸、ポリイソプレンスルホン酸、Nースルホアルキル化ポリアニリン、核ス

ルホン化ポリアニリン等を挙げることができる。ナフイオン (米国デユポン社登録商標) として知られている含フッ素重合体も、ポリマー酸として好適に用いられる。

【0030】本発明においては、上記のようなプロトン酸からなるドーパントを製膜溶液に含有させる方法として、特開平3-28229号公報に示されるように、例えば、トリエチルアミンのような塩基性物質をドーパントと共に加える方法も、好適に用いることができる。

【0031】このようなプロトン酸は、前記一般式

(I)で表わされるポリアニリンのキノンジイミン構造のイミン窒素へのプロトン化によって、ポリアニリンを導電性とする。通常、前述したように、アニリンを溶液中で酸化重合して得られる前記一般式(I)で表わされるキノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリンにおいては、式中、mとnの値はほぼ相等しい。

【0032】このように、キノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリンは、キノンジイミン構造を多く有するので、プロトン酸によるドーピングによって、高導電性を有するポリアニリンを与える。

【0033】本発明においては、式(川)

[0034]

【化4】

【0035】で表わされるイミノーpーフェニレン構造単位を主たる繰返し単位として有する溶剤可溶性のポリアニリン(以下、イミノーpーフェニレン型のポリアニリンということがある。)は、上記キノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリンに比べて、種々の有機溶剤に一層よく溶解するので、上記キノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリンと共に、又は上記キノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリンに代えて、用いることができる。

【0036】このようなイミノーpーフェニレン型のポリアニリンは、特開平3-52929号公報に記載されているように、前記キノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリンを還元剤にて還元することによって得ることができる。本発明においては、このようなイミノーpーフェニレン型のポリアニリンも、Nーメチルピロリドン中、30℃で測定した極限粘度〔η〕が0.40d1/g以上であることが好ましい。

【0037】上記還元剤としては、フェニルヒドラジン、ヒドラジン、ヒドラジン水和物、硫酸ヒドラジン、塩酸ヒドラジン等のヒドラジン化合物、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素リチウム等の還元性水素化金属化合物等が好適に用いられる。還元反応後に残渣を生じないので、ヒドラジン水和物又はフェニルヒドラジンが還元剤として特に好ましく用いられる。

【0038】このようなイミノーpーフェニレン型のポ リアニリンを用いるときは、これを含む製膜溶液を基材 上にキャステイングし、基材上に上記製膜溶液の層を形 成し、加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次い で、その樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹 脂シートを更に加熱して、ポリアミド酸をイミド化させ る際に、空気酸化によって、キノンジイミン・フェニレ ンジアミン型のポリアニリンとなり、製膜溶液がドーパ ントを含むときは、このキノンジイミン・フェニレンジ アミン型のポリアニリンをドーピングして、導電性のポ リアニリンを形成し、半導電性の樹脂シートを与える。 【0039】本発明による半導電性樹脂シートの形状は 特に限定されるものではなく、前述したように、平面的 若しくは曲面を有するシート状のほか、チューブ状であ ってもよい。また、不連続であっても、連続していても よい。

[0040]

【発明の効果】本発明によれば、以上のように、ポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンと(このポリアニリンをドーピングして導電性とすることができるドーパントと)を含む製膜溶液から製膜することによって、簡単にポリイミドと(脱)ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなる半導電性樹脂シートを得ることができる。

【 O O 4 1 】特に、本発明に従って、脱ドープ状態のポリアニリンを用いて得られる半導電性樹脂シートは、本来、ドーパントを含まないために、水分等の環境条件の変動にかかわらず、その半導電性は実質的に一定ある。他方、本発明に従って、脱ドープ状態のポリアニリンをドーピングして導電性とするドーパントを含む製膜溶液を用いて、半導電性樹脂シートとするときは、製膜後にドーピングする方法と異なり、製膜によって、直ちに、半導電性樹脂シートを得ることができ、しかも、得られる半導電性樹脂シートにおいては、ドーパントが水分や熱等の環境の影響によって脱ドープし難く、かくして、環境に対して安定した半導電性を有する。

[0042]

【実施例】以下に参考例と共に、実施例を挙げて本発明 を説明するが、本発明はこれら実施例により何ら限定さ れるものではない。

【0043】参考例1

(アニリンの酸化重合によるドープ状態のポリアニリンの製造) 撹拌装置、温度計及び直管アダプターを備えた10リットル容量セパラブル・フラスコに蒸留水6000g、36%塩酸360ml及びアニリン400g(4.295モル)をこの順序にて仕込み、アニリンを溶解させた。別に、氷水にて冷却しながら、ビーカー中の蒸留水1493gに97%濃硫酸434g(4.295モル)を加え、混合して、硫酸水溶液を調製した。この硫酸水溶

液を上記セパラブル・フラスコに加え、フラスコ全体を 低温恒温槽にてー4℃まで冷却した。

【0044】次に、ビーカー中にて蒸留水2293gにペルオキソニ硫酸アンモニウム980g(4.295モル)を加え、溶解させて、酸化剤水溶液を調製した。フラスコ全体を低温恒温槽で冷却して、反応混合物の温度を-3℃以下に保持しつつ、攪拌下にアニリン塩の酸性水溶液に、チュービングポンプを用いて、直管アダプーから上記ペルオキソニ硫酸アンモニウム水溶液を1ml/分以下の割合にて徐々に滴下した。最初、無色透明の溶液は、重合の進行に伴って緑青色から黒緑色となり、次いで、黒緑色の粉末が析出した。この粉末析出時に反応混合物において温度の上昇がみられるが、反応系内の温度を-3℃以下に抑えた。

【0045】かくして、7時間を要して、ペルオキソニ 硫酸アンモニウム水溶液の滴下を終了した後、更に1時間、-3℃以下の温度にて攪拌を続けた。得られた粉末を濾別し、水洗、アセトン洗浄し、室温で真空乾燥して、硫酸にてドープされた導電性ポリアニリン430gを黒緑色の粉末として得た。

【0046】(ドープ状態の導電性ポリアニリンのアンモニアによる脱ドーピング)上記ドープ状態の導電性ポリアニリン粉末350gを2Nアンモニア水4リットル中に加え、オートホモミキサーにて回転数5000rpmにて5時間攪拌した。混合物は、黒緑色から青紫色に変化した。ブフナー漏斗にて粉末を濾別し、ビーカー中に攪拌しながら、蒸留水にて濾液が中性になるまで繰り返し洗浄し、続いて、濾液が無色になるまでアセトンにて洗浄した。この後、粉末を室温にて10時間真空乾燥して、黒褐色の脱ドープされたポリアニリン粉末280gを得た。

【0047】参考例2

(ポリイミド前駆体溶液Aの調製) 3,3',4,4'ーピフェニルテトラカルボン酸二無水物とpーフェニレンジアミンのほぼ等モル混合物をNーメチルー2ーピロリドン溶液(濃度20重量%)中で温度20~60℃で12時間反応させて、粘度1000ポイズ(温度25℃、B型粘度計での測定値)、固定粘度2.1のポリアミド酸溶液を調製した。

【0048】(ポリイミド前駆体溶液Bの調製)ピロメリット酸二無水物と3,3',4,4'ージアミノジフェニルエーテルのほぼ等モル混合物をNーメチルー2ーピロリドン溶液(濃度20重量%)中で温度5~20℃で10時間反応させて、粘度200ポイズ(温度25℃、B型粘度計での測定値)、固有粘度2.5のポリアミド酸溶液を調製した。

【0049】 実施例1

N-メチルー2ーピロリドン180gにフェニルヒドラジン2.98gを溶解させ、次いで、参考例1にて得られたポリアニリン粉末20gをこれに溶解させて、10重

量%の脱ドープ状態のポリアニリン溶液を得た。次いで、このポリアニリン溶液に参考例2にて得られたポリイミド前駆体溶液 A 1 O O g を添加し、1 時間攪拌して、脱ドープ状態のポリアニリンとポリイミド前駆体とからなる製膜溶液を得た。

【0050】この製膜溶液を用いて、次のようにして製膜した。即ち、上記製膜溶液を 120μ mのギャップのナイフコーターを用いてガラス板上にコーティングした後、150℃で20分、200℃で20分、250℃で20分、最後に300℃で20分処理して、溶剤除去とイミド化を行なった後、ガラス板から剥離して、脱ドープ状態のポリアニリンとポリイミドとのポリマーブレンドからなる厚さ 15μ mの半導電性樹脂シートを得た。【0051】この半導電性樹脂シートは、脱ドープ状態のポリアニリン50重量%とポリイミド50重量%とからなり、体積抵抗率は $3\times10^{11}\,\Omega$ ・cm であり、引張試験の結果、強度 $24\,kgf/mm^2$ 、弾性率 $520\,kgf/mm^2$ であった。

【0052】実施例2

実施例1と同様にして、10重量%濃度の脱ドープ状態のポリアニリン溶液200gを調製した。次いで、このポリアニリン溶液に参考例2で得られたポリイミド前駆体溶液B300gを添加し、1時間攪拌して、脱ドープ状態のポリアニリンとポリイミド前駆体とからなる製膜溶液を得た。

【0053】この製膜溶液を用いて、次のようにして製膜した。即ち、上記製膜溶液を 240μ mのギャップのナイフコーターを用いてガラス板上にコーティングした後、実施例 1 と同様にして、溶剤除去とイミド化を行なった後、ガラス板より剥離して、ポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなる厚さ 30μ mの半導電性樹脂シートを得た。

【0054】この半導電性樹脂シートは、脱ドープ状態のポリアニリン25重量%とポリイミド75重量%とからなり、体積抵抗率は $4\times10^{12}\Omega$ ・cm であり、引張試験の結果、強度 16 kgf/mm 2 、弾性率 26 O kgf/mm 2 であった。

【0055】実施例3

実施例1と同様にして、10重量%濃度の脱ドープ状態のポリアニリン溶液200gを調製した。別に、pートルエンスルホン酸一水和物(ドーパント)12.6gをNーメチルー2ーピロリドン113.5gに溶解して、10重量%pートルエンスルホン酸溶液を調製した。次いで、これらの2つの溶液を混合して、ドープ状態のポリアニリンの溶液を調製した。

【0056】この溶液に参考例2で得られたポリイミド前駆体溶液A100gを添加した後、1時間攪拌して、ドープ状態のポリアニリンとポリイミド前駆体とからなる製膜溶液を得た。この製膜溶液を240μmのギャップのナイフコーターでガラス板上にコーティングした

後、1 5 0 ℃で3 0 分間、加熱して、溶剤を除去した。 このようにして得られたシートをガラス板から剥離し、 3 0 0 ℃で2 0 間加熱して、ポリイミドと p ートルエン スルホン酸でドープされたポリアニリンとからなるポリ マーブレンドの厚さ 2 5 µ mの半導電性樹脂シートを得 た。

【0057】この半導電性樹脂シートは、ドープ状態のポリアニリン50重量%とポリイミド50重量%とからなり、厚さ 25μ mであった。この半導電性樹脂シートの体積抵抗率を測定したところ、 $8\times10^{10}\Omega$ ・cmであった。また、表面抵抗を測定したところ、 2×10^9 Ω /口であった。上記半導電性シートを蒸留水中に24 時間浸漬した。乾燥させた後、体積抵抗率を測定したところ、 $1\times10^{11}\Omega$ ・cmであった。

【0058】実施例4

実施例1と同様にして、10重量%濃度の脱ドープ状態のポリアニリン溶液200gを調製した。別に、ドデシルベンゼンスルホン酸(ドーパント)21.5gをNーメチルー2ーピロリドン193.5gに溶解して、10重量%ドデシルベンゼンスルホン酸溶液を調製した。次いで、これらの2つの溶液を混合して、ドープ状態のポリアニリンの溶液を調製した。

【0059】この溶液に参考例2で得られたポリイミド 前駆体溶液Aを100gを添加した後、1時間攪拌し て、ドープ状態のポリアニリンとポリイミド前駆体とか らなる製膜溶液を得た。この製膜溶液を240μmのギ ャップのナイフコーターでガラス板上にコーティングした後、150 Cで30 分間、加熱して、溶剤を除去した。このようにして得られたシートをガラス板から剥離し、300 Cで20 間加熱して、ポリイミドとドデシルベンゼンスルホン酸でドープされたポリアニリンとからなるポリマーブレンドの厚さ 25μ mの半導電性樹脂シートを得た。

【0060】この半導電性樹脂シートは、ドープ状態のポリアニリン50重量%とポリイミド50重量%とからなり、厚さ 25μ mであった。この半導電性樹脂シートの体積抵抗率を測定したところ、 $2\times10^{11}\Omega$ ・cmであった。また、表面抵抗を測定したところ、 $2\times10^{10}\Omega$ / \square であった。

【0061】比較例1

蒸留水 400 gにp-hルエンスルホン酸 100 gを溶解させ、これにメタノール 500 gを加えて、ドーパント溶液を調製した。このドーパント溶液に実施例 1 で得られたポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなる半導電性樹脂シートを 60 時間浸漬して、ポリアニリンのドーピングを行なった。得られた樹脂シートの体積抵抗率を測定したところ、 7×10^{10} Ω · cm であった。また、この樹脂シートを実施例 5 と同様にして蒸留水中に 2 4 時間浸漬し、乾燥させた後、表面抵抗を測定したところ、 9×10^{11} Ω · cm であった。

フロントページの続き

(72)発明者 阿部 正男

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東 電工株式会社内 Fターム(参考) 4F071 AA58 AA59 AA60 AH12 AH15 AH19 BA02 BB02 BC01 BC10 BC17

> 4J002 CM01X CM04W FD11X GQ00 GQ02 GR00

5G301 DA28 DA51 DD05 DD06 DE10